

日程表 (会場別:K101-K406)

3月14日(金)・15日(土)

会場名	収容人数	2025年3月14日(金)		2025年3月15日(土)	
		午前	午後	午前	午後
K101 (講義棟)	214	9:00 ~ 12:15 13.5 デバイス／配線／集積化技術	13:30 ~ 16:40 T23 IoT社会への進展を支える半導体産業のコア技術～融合と多様化～	9:00 ~ 12:00 13.5 デバイス／配線／集積化技術	13:30 ~ 17:30 T24 【一般公開】実装技術アラカルトⅡ：最先端半導体実装技術と将来展望
K102 (講義棟)	214		13:30 ~ 16:50 T29 マテリアルデータベースの新展開 ―知識を蓄積・抽出・俯瞰する―	10:30 ~ 11:45 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 17:40 T14 プラズマ活性溶液とその応用
K103 (講義棟)	265	9:00 ~ 11:15 KS.2 量子情報工学研究会	13:00 ~ 17:15 T1 誤り耐性量子コンピュータへの新技術		13:30 ~ 16:00 NT1 【一般公開】就活生必見！あなたならできる半導体のイノベーション ～創造力で新しい時代を～
K201 (講義棟)	126	9:00 ~ 10:45 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:00 ~ 17:30 T7 化合物半導体を用いた蛍光体開発の現状と展望		13:30 ~ 17:10 T9 応用物理の交差点：ガラスとレーザープロセスの新展開
K202 (講義棟)	126		14:00 ~ 16:30 チュートリアル (有料)		13:30 ~ 17:55 T12 生物・有機分子ダイナミクスにインスパイアされたセンサ・アクチュエータ機能と創発秩序
K203 (講義棟)	178		13:30 ~ 17:35 T21 多元系発光材料の新展開－カルコバイライトからペロブスカイトまで－	10:00 ~ 11:25 T11 放射光利用による先端材料研究開発	13:30 ~ 17:20 T11 放射光利用による先端材料研究開発
K204 (講義棟)	126	9:00 ~ 12:00 T18 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測	13:30 ~ 16:15 T18 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測	9:30 ~ 11:45 T4 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展	13:30 ~ 15:30 T4 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展
K205 (講義棟)	126	10:15 ~ 12:00 1.1 応用物理一般・学際領域	13:30 ~ 17:15 T19 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 -ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能な グラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -	9:15 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:00 ~ 15:30 T5 非大都市圏に向けた科学・エネルギー教育の展開
K206 (講義棟)	126		13:30 ~ 17:25 T17 高温超伝導体の新しい潮流 ～銅酸化物を超える材料は現れるのか？～		13:30 ~ 18:45 T2 グリーンファブの未来を拓く：持続可能なものづくりへの挑戦
K207 (講義棟)	126		13:30 ~ 19:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	9:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 17:45 T3 固体量子ビットを用いた量子科学技術の最前線
K209 (講義棟)	84	9:00 ~ 12:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:30 ~ 15:15 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	10:15 ~ 11:30 11.1 基礎物性	13:30 ~ 16:45 11.1 基礎物性
K210 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:30 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 16:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性		13:30 ~ 16:45 1.6 超音波
K301 (講義棟)	160		13:30 ~ 18:15 17.3 層状物質	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	15:45 ~ 19:00 17.3 層状物質
K302 (講義棟)	126	10:30 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 17:15 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	9:00 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 16:30 13.9 化合物太陽電池
K303 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 17:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	9:00 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 15:15 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)
K304 (講義棟)	160	9:00 ~ 12:15 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 18:30 3.7 光計測技術・機器	9:00 ~ 12:15 3.7 光計測技術・機器	15:45 ~ 19:00 3.7 光計測技術・機器
K305 (講義棟)	160		13:30 ~ 17:30 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域
K306 (講義棟)	160	9:00 ~ 11:45 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 14:15 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	9:00 ~ 12:00 3.3 生体・医用光学	13:30 ~ 16:30 3.3 生体・医用光学
K307 (講義棟)	84			9:00 ~ 12:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:30 ~ 17:30 9.4 熱電変換
K308 (講義棟)	84		13:30 ~ 16:30 3.5 超高速・高強度レーザー	10:00 ~ 11:45 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 15:50 3.5 超高速・高強度レーザー
K309 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:45 3.4 レーザー装置・材料	13:30 ~ 17:45 3.4 レーザー装置・材料	9:30 ~ 11:30 3.9 光子量子物理・技術	13:30 ~ 16:45 3.9 光子量子物理・技術
K310 (講義棟)	84		12:30 ~ 15:30 1.2 教育	10:00 ~ 12:00 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	14:00 ~ 16:15 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶
K401 (講義棟)	214	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 15.4 III-V族窒化物結晶
K402 (講義棟)	126		13:00 ~ 15:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	9:00 ~ 11:15 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	13:00 ~ 15:30 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御
K403 (講義棟)	126		13:00 ~ 16:45 6.2 カーボン系薄膜	9:00 ~ 12:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	14:30 ~ 18:45 12.7 医用工学・バイオチップ
K404 (講義棟)	126		13:30 ~ 18:00 12.2 評価・基礎物性	9:00 ~ 12:15 12.2 評価・基礎物性	13:45 ~ 18:45 12.2 評価・基礎物性
K405 (講義棟)	214	11:00 ~ 12:00 授賞式	16:00 ~ 18:00 授賞式	9:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 17:15 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
K406 (講義棟)	126		13:00 ~ 17:15 12.1 作製・構造制御	9:00 ~ 12:00 KS.2 量子情報工学研究会	13:30 ~ 16:00 KS.2 量子情報工学研究会

日程表 (会場別:K101-K406)

3月16日(日)・17日(月)

会場名	収容人数	2025年3月16日(日)		2025年3月17日(月)	
		午前	午後	午前	午後
K101 (講義棟)	214	:00 勿質	13:30 ~ 16:55 T26 極薄物質で本当に良いセンサーができるのか? ~ ナノチューブ・二次元材料を用いた分子センシングの現状と課題 ~	9:00 ~ 12:30 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 16:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術
K102 (講義棟)	214	:15 5用	13:30 ~ 17:45 T16 磁気・スピンをみる—イメーシング技術を駆使したマグネティクス・スピントロニクスの新展開—	9:30 ~ 11:45 17.3 層状物質	13:30 ~ 16:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス
K103 (講義棟)	265	9:00 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 18:05 T10 革新的フォトニクスが拓く光学の最前線	9:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 16:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術
K201 (講義棟)	126		13:30 ~ 17:30 NT2【一般公開】理工系人材の枯渇危機をどう乗り越えるか?! —15歳からのキャリアパスを考える—	9:00 ~ 11:45 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術	13:30 ~ 16:25 T8 植物RIイメーシング技術の開発と農業への応用
K202 (講義棟)	126	9:30 ~ 12:00 T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術	13:30 ~ 17:15 T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術	9:30 ~ 11:45 13.3 絶縁膜技術	13:00 ~ 14:45 13.3 絶縁膜技術
K203 (講義棟)	178	:45 エレクトロニクス	13:30 ~ 17:40 T13 次世代トランジスタに向けた新規機能性酸化半導体チャネル材料・デバイス・作製技術の新展開		
K204 (講義棟)	126	10:00 ~ 12:05 T6【一般公開】音と応用物理のコラボレーション	13:30 ~ 15:45 T6【一般公開】音と応用物理のコラボレーション	10:15 ~ 12:00 T20 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望	13:30 ~ 15:45 T20 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望
K205 (講義棟)	126	:30 —ハーベスティング	13:00 ~ 17:30 T27 カーボンニュートラルを実現する半導体低消費電力化技術の最前線	10:00 ~ 11:35 T28 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線	13:00 ~ 15:35 T28 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線
K206 (講義棟)	126	9:00 ~ 10:45 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	13:00 ~ 15:15 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		
K207 (講義棟)	126	:45 ン			
K209 (講義棟)	84	9:00 ~ 12:00 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	13:30 ~ 18:00 11.4 アナログ応用および関連技術	10:00 ~ 12:00 1.5 計測技術・計測標準	13:30 ~ 15:45 1.5 計測技術・計測標準
K210 (講義棟)	84				
K301 (講義棟)	160	9:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	14:00 ~ 17:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	9:00 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:15 ~ 17:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価
K302 (講義棟)	126	1:30 主・発光デバイス	13:30 ~ 15:00 13.8 光物性・発光デバイス	10:00 ~ 11:30 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	13:30 ~ 16:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス
K303 (講義棟)	126	:45 ライフサイエンス	13:30 ~ 16:00 8.4 プラズマライフサイエンス	9:00 ~ 12:00 8.1 プラズマ生成・診断	13:30 ~ 16:00 8.1 プラズマ生成・診断
K304 (講義棟)	160		13:30 ~ 17:15 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 17:15 ~ 17:45 8.6 Plasma Electronics English Session	9:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 15:45 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理
K305 (講義棟)	160	9:00 ~ 11:15 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	13:30 ~ 18:00 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	9:00 ~ 11:30 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	13:30 ~ 17:00 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御
K306 (講義棟)	160	9:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 16:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	9:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 16:45 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
K307 (講義棟)	84	:45 クロニクス	13:30 ~ 18:30 9.1 誘電材料・誘電体		13:00 ~ 17:00 9.5 新機能材料・新物性
K308 (講義棟)	84	:30 系太陽電池	13:30 ~ 17:15 16.3 シリコン系太陽電池	9:30 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 16:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
K309 (講義棟)	84	1:15 換	13:30 ~ 16:15 3.12 半導体光デバイス	10:00 ~ 12:30 3.12 半導体光デバイス	
K310 (講義棟)	84	9:30 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 14:45 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	9:30 ~ 12:00 15.1 バルク結晶成長	13:30 ~ 14:00 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶
K401 (講義棟)	214	:30 族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	
K402 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア	13:00 ~ 17:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 16:00 12.6 ナノバイオテクノロジー
K403 (講義棟)	126	:15 系薄膜	13:00 ~ 16:45 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 11:30 12.7 医用工学・バイオチップ	13:00 ~ 16:45 12.7 医用工学・バイオチップ
K404 (講義棟)	126		13:00 ~ 16:00 12.4 有機EL・トランジスタ		13:00 ~ 16:30 12.4 有機EL・トランジスタ
K405 (講義棟)	214	:30 ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 17:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	9:00 ~ 11:45 CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)	13:00 ~ 15:15 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
K406 (講義棟)	126	:30 オ料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 17:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 15:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス

日程表 (会場別:K501-K509,Y1311, P)

3月14日(金)・15日(土)

会場名	収容人数	2025年3月14日(金)		2025年3月15日(土)	
		午前	午後	午前	午後
K501 (講義棟)	126			10:00 ~ 11:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:00 ~ 16:30 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」
K502 (講義棟)	126	9:30 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 16:15 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	9:00 ~ 11:45 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	13:00 ~ 17:00 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価
K503 (講義棟)	178		13:00 ~ 17:45 CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェア	9:00 ~ 11:15 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 17:00 6.1 強誘電体薄膜
K504 (講義棟)	178		13:00 ~ 16:30 3.8 テラヘルツ全般	9:15 ~ 11:30 3.8 テラヘルツ全般	13:00 ~ 17:30 3.8 テラヘルツ全般
K505 (講義棟)	178		13:30 ~ 17:30 3.10 フォトニック構造・現象	9:30 ~ 11:45 3.10 フォトニック構造・現象	13:15 ~ 15:30 3.10 フォトニック構造・現象 15:45 ~ 18:30 CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御のコードシェア
K506 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:45 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15 ~ 18:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	9:00 ~ 11:45 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15 ~ 18:30 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学
K507 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:30 CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	13:00 ~ 18:00 CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	9:00 ~ 11:15 7.2 電子ビーム応用	13:00 ~ 15:15 7.2 電子ビーム応用
K508 (講義棟)	84		13:00 ~ 16:15 3.14 Optics and Photonics English Session	9:00 ~ 11:15 3.2 情報フォトニクス・画像工学	13:00 ~ 18:15 3.2 情報フォトニクス・画像工学
K509 (講義棟)	84			10:00 ~ 11:30 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:30 ~ 15:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション
Y1311 (13号館)	500		14:00 ~ 15:30 T22 次世代半導体創生に向けた研究・人財育成活動シンポジウム		13:30 ~ 16:45 T25 極限環境デバイス
P 森戸記念 体育館		[09:30-11:30] 2 放射線 7 ビーム応用 8.4 プラズマライフサイエンス 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 11 超伝導	[13:30-15:30] 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.4 III-V族窒化物結晶 FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	[09:30-11:30] 3.6 レーザープロセシング 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.4 有機EL・トランジスタ 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 16 非晶質・微結晶	[13:30-15:30] 3.4 レーザー装置・材料 3.7 光計測技術・機器 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御 3.14 Optics and Photonics English Session 17 ナノカーボン・二次元材料 23 合同セッションN「インフォマティクス応用」
			[16:00-18:00] 1 応用物理学一般 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥 T22 次世代半導体創生に向けた研究・人財育成活動シンポジウム		
					[16:00-18:00] 10 スピントロニクス・マグネティクス 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.5 デバイス／配線／集積化技術 13.8 光物性・発光デバイス 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」

日程表 (会場別:K501-K509,Y1311, P)

3月16日(日)・17日(月)

会場名	収容 人数	2025年3月16日(日)		2025年3月17日(月)	
		午前	午後	午前	午後
K501 (講義棟)	126		13:00 ~ 18:15 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術	9:30 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 15:30 6.3 酸化物エレクトロニクス
K502 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	13:00 ~ 16:45 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	9:00 ~ 11:30 CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ 研究会のコードシェア	13:00 ~ 15:15 CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ 研究会のコードシェア
K503 (講義棟)	178		13:00 ~ 15:30 KS.1 固体量子センサ研究会	10:00 ~ 11:30 6.6 フローブ顕微鏡	13:00 ~ 16:30 6.6 フローブ顕微鏡
K504 (講義棟)	178	10:00 ~ 11:30 6.6 フローブ顕微鏡	13:00 ~ 17:00 6.4 薄膜新材料	9:30 ~ 11:00 6.4 薄膜新材料	
K505 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 17:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	9:00 ~ 11:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 16:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
K506 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:45 3.6 レーザープロセスング	13:00 ~ 18:30 3.6 レーザープロセスング	9:00 ~ 12:00 3.6 レーザープロセスング	
K507 (講義棟)	84		13:00 ~ 17:30 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、 7.4 イオンビーム一般のコードシェア	9:00 ~ 10:45 7.1 X線技術	13:00 ~ 14:45 7.3 微細パターン・微細構造形成技術
K508 (講義棟)	84	9:00 ~ 12:00 13.5 デバイス／配線／集積化技術	13:00 ~ 14:45 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学		
K509 (講義棟)	84				
Y1311 (13号館)	500	9:00 ~ 11:30 21.1 合同セッション K 「ワイドギャップ酸化物半導 体材料・デバイス」	13:00 ~ 17:15 21.1 合同セッション K 「ワイドギャップ酸化物半導 体材料・デバイス」	9:00 ~ 11:45 21.1 合同セッション K 「ワイドギャップ酸化物半導 体材料・デバイス」	13:00 ~ 15:45 21.1 合同セッション K 「ワイドギャップ酸化物半導 体材料・デバイス」
P 森戸記念 体育館		[09:30-11:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 情報フォトニクス・画像工学 3.3 生体・医用光学 3.5 超高速・高強度レーザー 3.8 デラヘルツ全般 3.10 フォトニック構造・現象 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 3.12 半導体光デバイス 22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[13:30-15:30] 8.1 プラズマ生成・診断 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 プラズマナノテクノロジー 12.1 作製・構造制御 12.2 評価・基礎物性 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	[09:30-11:30] 9 応用物性	
			[16:00-18:00] 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.5 表面物理・真空 6.6 フローブ顕微鏡 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.9 化合物太陽電池 KS 研究会セッション	12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカ イトの光電物性・デバイス作製・構造制御	